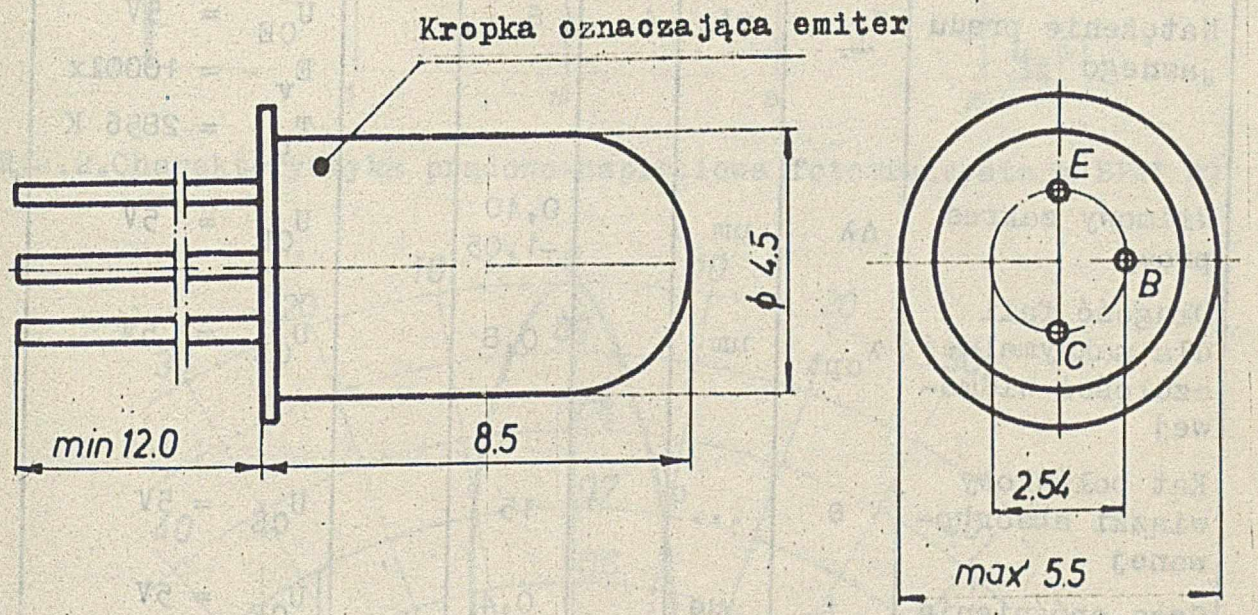
FOTOTRANZYSTOR BPXP 29

BPXP 29 jest krzemowym epiplanarnym fototranzystorem n-p-n z wyprowadzoną bazą. Montowany jest w obudowie plastikowej z soczewką. BPXP 29 jest szybkim fototranzystorem o dużej czułości. Znajduje zastosowanie w czujnikach optycznych, układach automatyki i sterowania w przetwornikach analogowo-cyfrowych.



Rys.1. Obudowa fototranzystora BPXP 29

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

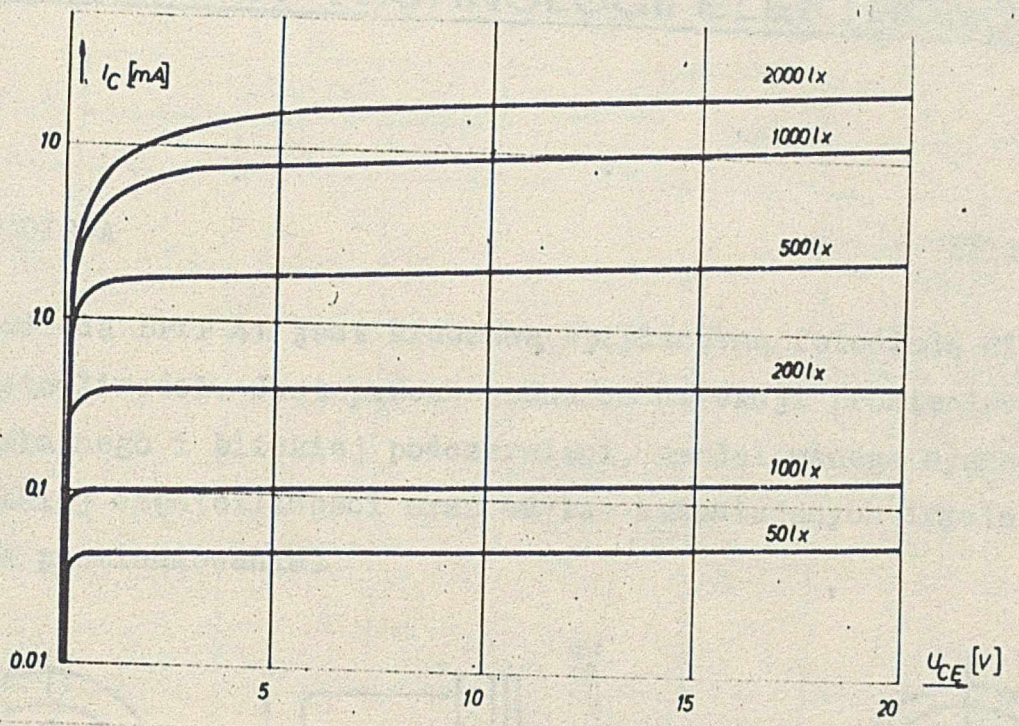
Napięcie kolektor-baza	U_{CB} = 70V
Napięcie kolektor -emiter	U_{CE} = 70V
Napięcie emiter-baza	U_{EB} = 7V
Napięcie emiter-kolektor	U_{EC} = 5V
Moc całkowita strat /$t_{amb} \leqslant 45^{o}C$/	P_{tot} = 100 mW

Temperatura złącza . $t_j = 100^oC$

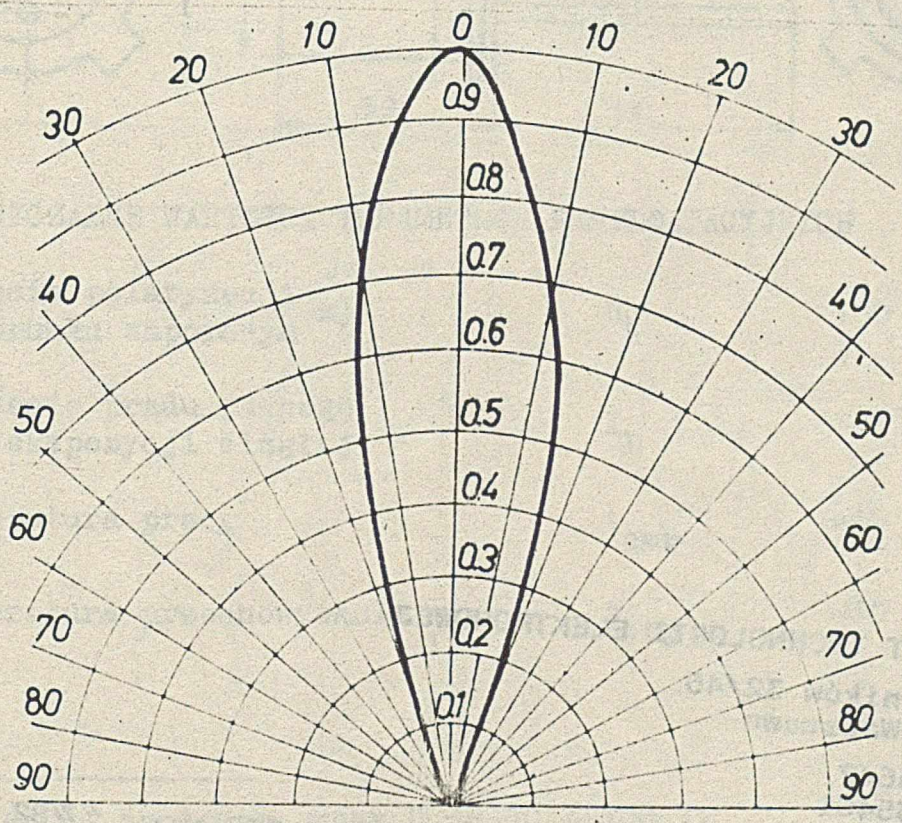
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy . $t_{amb} = -40 \div +70^oC$

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru
			min.	typ.	max.	
Natężenie prądu ciemnego	I_{CEO}	nA		5	50	$U_{CE} = 30V$ $I_B = 0$
Natężenie prądu jasnego	I_L	mA	4	6		$U_{CE} = 5V$ $E_v = 1000lx$ $T_b = 2856$ K
Widmowy zakres pracy	$\Delta\lambda$	um		0,40 ÷1,05		$U_{CE} = 5V$
Długość fali dla maksymalnej czułości widmowej	λ_{opt}	um		0,8		$U_{CE} = 5V$
Kąt połówkowy wiązki absorbowanej	θ	...°		15		$U_{CE} = 5V$
Czas opóźnienia	t_d	/us		0,4		$U_{CE} = 5V$ $I_C = 3$ mA $I_B = 0$ $\lambda = 0,9$ /um $R_L = 100\ \Omega$
Czas narastania	t_r	/us		0,8	1,2	
Czas magazynowania	t_s	/us		0,1		
Czas opadania	t_f	/us		0,5	1,0	



Rys.2.Charakterystyka prądowo-napięciowa fototranzystora BPXP 29



Rys.3.Charakterystyka kątowa czułości BPXP 29

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

tlx 815647
tel. 435401

Cena 12 zł

Druk ZOINTE ITE zam. 47/82 n.500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE